19日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 118424

@Int_CI_4

識別記号

庁内整理番号

砂公開 昭和61年(1986)6月5日

C 08 G 73/10 C 08 L 79/08 101

7016-

審査請求 未請求 発明の数 6 (全13頁)

❷発明の名称

可溶性シリコーンーイミドコポリマー

创特 願 昭60-231489

日本 願 昭60(1985)10月18日

優先権主張

到1984年10月19日發米菌(US)到662930

72 発 明 者

チャン・ジェン・リー

アメリカ合衆国、ニユーヨーク州、バルストン・レイク、

バーニング・ブツシユ・ブルーパード、14番

⑪出 願 ゼネラル・エレクトリ ツク・カンパニイ

アメリカ合衆国、12305、ニユーヨーク州、スケネクタデ

イ、リバーロード、1番

130代 理 人

弁理士 生沼 徳二

/ 発明の名称

可溶性シリコーン・イミドゴポリマ・

ふ 特許請求の範囲

(1) ガラス転移温度が低いポリマープロック少 なくとも!つとガラス転移温度が高いポリマーブ ロック少なくとも!つとを有するシロキサン・イ ミドコポリマー組成物。

(2) ガラス転移温度が低い少なくとも/つのポ リマーブロックが式:

〔式中、Ar は四個の芳香族基であり、Rは健換 もしくは非世換のヒドロカルビレン基または式:

$$-Q-Z-R^{5}-$$

(式中、Qは量換または非世換の芳香族基であり、

HO OH ||| ||| ||| || -NC-, -CN-, -C-O-または-O-C-であ り、 RԿ は世後または非世換のヒドロカルピレン である)の基であり、各 R はそれぞれ独立に遇 択された置換または非置換のヒドロカルビル基で あり、ロはノに等しいかまたはこれより大きい整 数である〕を有することを特徴とする併許請求の 飯田鉄ノ項に記載の組成物。

(3) ガラス転移温度が高い少なくともノつのポ リマープロックが式:

特開昭61-118424 (2)

〔式中、 Ar は二価の芳香族基であり、 R は

(式中、 R⁴ は炭素原子を/~9個有するアルキル基であり、 R⁵ は炭素原子を/~4個有するアルキレン基である)から成る群から選択された基であり、Yは酸素またはイオウである]を有することを特徴とする特許請求の範囲第/項または第2項に記載の組成物。

(4) 一般式:

(式中、Pは炭素原子を/~9個有するアルキル基であり、Piは炭素原子を/~4個有するアルキ

$$\left\{
\begin{array}{c|c}
O & O \\
\parallel & \parallel \\
C & C \\
N & Ar & N-R \\
\hline
C & C \\
\parallel & \parallel \\
O & O
\end{array}
\right.$$

$$\left(\begin{array}{c|c}
R^{i} \\
\vdots \\
SiO \\
R^{i}
\end{array}
\right)_{n} \quad \left(\begin{array}{c}
R^{i} \\
\vdots \\
R^{i}
\end{array}\right)_{n} \quad \left(\begin{array}{c}
R^{i} \\
\vdots \\
R^{i}$$

〔式中、各 Ar はそれぞれ独立に選択された芳香 族基であり、Bは置換もしくは非世族のヒドロカ ルビレン基または式:

$$-Q-Z-R^{s}-$$

(式中、Qは置換または非道換の芳香族基であり、 Zは

レン基である)から成る群から選択された基であり、Yは酸素またはイオウであり、a.b.cおよびロは全てノに等しいかまたはこれより大きい整数である〕を有するジグライム可容性シロキサン・イミドコポリマー組成物。

(5) 少なくとも!個の Ar がペンゼン核、ナフタレン核または式:

$$(E)_{\overline{m}}$$

〔式中、mはOまたはノであり、Eは-O-.

ただし、yは/~8の整数である)である了の核 を有することを特徴とする特許請求の範囲第4項 に記載の組成物。

(6) 少なくとも/個の Ar が式:

〔式中、Gはフェニレンまたは式:

【式中、四は0または/であり、Eは-0-.

ただし、gはノ〜8の整数である)である)の基 である〕を有することを停倒とする特許請求の範 囲第4項に記載の組成物。

(7) 少なくともノ個の Ar 基が式:

とする特許請求の範囲第8項に記載の組成物。

(3) 感光性の基を少なくとも1つ含有することを特徴とする特許請求の範囲第4項に記載の組成物。

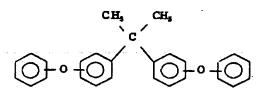
44 前記感光性の基がアクリレート類、シンナメート類、2,3-ジフェニルシクロプロペノールエステル類またはこれらの混合物であることを特徴とする特許許水の範囲第 /3 項に記載の組成物。

(19 (A) 適当な器媒中で、

(|)有機二無水物を、ジアミノで末端停止したポリシロキサンと、および

(肌)有機二無水物を有機ジアミンと、反応させ、

- (B) (A)(i)の反応生成物を(A)(i)の反応生成物と混合し、これらを反応させ、
- (C) (B)の反応生成物を加熱してイミド化することからなる、ガラス転移温度が低いポリマーブロックを少なくとも/つとガラス転移温度が高いポリマーブロックを少なくとも/つ有するシロキサン・イミドコポリマー組成物の製造方法。



を有することを特徴とする特許請求の範囲無以項 に記載の組成物。

- (8) Rが低級アルキレン基であることを特徴と する特許線次の範囲解が項、第よ項または解る項 のいずれかに記載の組成物。
- (9) R¹ がメチル、エチル、プロピル、ブチル、フェニル、ピニルおよび 3, 3, 3 トリフルオロプロピル基からそれぞれ独立に選択されることを特徴とする特許請求の範囲第*る*項に記載の組成物。
- (0) ロがら〜/OOの整数であることを特徴とする特許請求の範囲第8項に記載の組成物。
- (1) Yが設案であることを特徴とする特許財水の範囲第3項に記載の組成物。
- C2 B^4 が炭素原子を $/\sim3$ 個有して*xり、 B^5 が炭素原子を/または2 個有していることを特徴

ととを特徴とする特許請求の範囲第 /5 項に記載 の方法。

II さらに、無溶媒組成物をジグライムに溶解させることを含むことを特徴とする特許求の範囲第 / 6 項に記載の方法。

(18) (A) 適当な唇族中で、

- (1)有機二無水物、有機ジアミン、およびジアミンで末端停止したポリシロキサン(ただし、有機 二無水物のモル量は有機ジアミンとジアミノで末 端停止したポリシロキサンのモル量の和にほぼ等 しい)を反応させ、
- (B) 反応生成物を加熱してイミド化することからなる、ガラス転移温度が低いポリマーブロックを少なくとも/つとガラス転移温度が高いポリマーブロックを少なくとも/つ有するシロキサン・イミドコポリマー組成物の製造方法。

19 さらに、反応容無を蒸発させることを含む ことを特徴とする特許請求の範囲第 /8 項に記載 の方法。

② さらに、無格棋組成物をジグライムに唇解

させることを含むことを特徴とする特許請求の氦 囲第 / 9 項に記載の方法。

(20) 基体上に、特許請求の範囲第/項、第2項、 第3項または第4項に記載の組成物を有する物品。

図 基体が電子デバイスであることを特徴とする特許請求の範囲第 2/ 項に記載の物品。

四 特許請求の範囲第ノ項、第2項、第3項ま たは第4項に記載の組成物を基体に並布すること からなる物品の製造方法。

20 組成物を搭媒中で重布することを特徴とする特許意味の範囲第 23 項に記載の方法。

協 加熱して番嬢を蒸発させることを特徴とする特許請求の範囲第 24 項に配載の方法。

3. 発明の詳細な説明

発明の背景

本発明はシロキサン単位とイミド単位の両者を有するポリマー組成物に係る。 さらに特定すると本発明はジグライム(すなわちジグリコールメチルエーテル類)に可溶なシロキサン・イミドコポリマーに係る。

性の高い辞媒に可辞であり、この形態で末端ユーザーに供給されている。

典型的な場合、来端ユーザーがポリアミド酸のコーティングを基体上に塗布した役約/50℃~約400℃の温度に加熱して番餅を除去しかつ環化を起こさせてたとえば次式(I)を有するシロキサン・イミドコポリマーを形成することによつて、シロキサン・イミドポリマーが作られる。

$$(1) \xrightarrow{\begin{pmatrix} C & C & C & C \\ II & C & C \\ II & C & C & C \\ II & C & C & C \\ II & C & C & C \\ I$$

たとえばジアミノシロギサンと、ベンゾフェノン二無水物のような二無水物とを反応させて次式(1)を有するポリアミド酸を得ることによつてシロキサン・イミドコポリマーを製造できることは業界で公知である。

(1)
$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ NH - C & 0 & C & C - NH - R \\ HO - C & C - OH & C - OH \\ 0 & 0 & 0 & C - OH \end{pmatrix}$$

$$\frac{\begin{pmatrix} R' \\ \vdots \\ SiO \end{pmatrix}_{m} \quad \begin{matrix} R' \\ \vdots \\ R' \end{matrix}}{\begin{pmatrix} R' \\ \vdots \\ R' \end{matrix}} - R \xrightarrow{n}$$

ここで、Rは二価の炭化水素基であり、R'は一価の炭化水素基であり、mは/より大きい整数であり、nは/0より大きい整数である。 これらのポリアミド酸はN-メチルピロリドンのような種

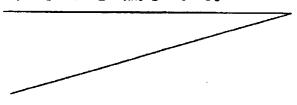
ホルブ(Holub)の米国特許第3325450号 には、上記の式(II)のポリイミド・シロキサンと、 ジアミノシロキサンと有极二無水物を反応させて ポリアミド酸を形成し、その後とのポリアミド酸 を加熱してイミド化させることによるその製法と

特開昭61-118424 (5)

が開示されている。 ホルブ (Holub)の数示の変形は米国券許第3392/44号、第3435,002号、第353282号、第353874/号、第3663728号および第3740305号にみることができる。

バージャー(Berger)の米国特許第403Q 948号には、テトラカルボン酸二無水物、有機 ジアミンおよびジ(アミノアルキル)ポリシロキ サンの反応生成物であるポリイミドコポリマーが 開示されている。 ここでジ(アミノアルキル) ポリシロキサンはポリマーの全アミン必要量の /8 ~ 45 モル乡を構成している。

バージャー(Berger)の米国特許部外39よ 520号には、 次式のシロキサン単位を含有する ポリイミドによつてポリイミドの番解性と接着性 が改良されることが開示されている。



ぞれ独立して0~100の値を有する。 一般に このようなポリイミドは、N. N -ジメチルアセト アミド、N - メチルカプロラクタム、ジメチルス ルホキシド、N-メチル・ユ-ピロリドン、テト ラメチル泉素、ピリジン、ジメチルスルホン、ヘ キサメチルホスホアミド、テトラメチレンスルホ ン、ホルムアミド、N - メチルホルムアミド、ブ チロラクトンおよびN-アセチル・2 - ピロリド ンのような極性溶媒の他に、ジクロロベンゼンお よびトリクロロベンゼンのような複楽化炭化水素 俘棋に可容であるとされている。 さらにバージ ャー(Berger)の数示するところでは、出発物の ノつとしてジェーテル含有紙水物を使用すると、 得られるポリイミドは上記の塩素化炭化水素器媒 と低性俗様ばかりでなく、これがシロキサン単位 を含有する場合、ポリイミドはエチレングリコー ルおよび縮合したポリエチレンケリコール類のモ ノアルキルおよび/またはジアルキルエーテル類 および/または今負以上の環を含有する環状エー テル類から誘導される裕姝、たとえばジグライム

$$Q - Z - D - Si - \begin{pmatrix} R^2 \\ i \\ OSi \\ R^2 \end{pmatrix}_{x} \begin{pmatrix} R^3 \\ i \\ OSi \\ R^4 \end{pmatrix}_{y} \begin{pmatrix} R^5 \\ i \\ OSi \\ R^6 \end{pmatrix}_{z}$$

a

ことで、Qは量換または非量換の芳香炭基であり、

-O-C- : であり、Dは非量換または量換の ヒドロカルビレンであり、R¹。R²。R³。R⁴。R⁵ お よび、R⁴ はそれぞれ独立して非量換または置換の ヒドロカルビル基であり、x、yおよび z はそれ

にも可容である。 しかし、パージャー(Bergar)はポリイミドのジグライムに対する語解度には限界があることを明らかにしている。 パージャー(Berger)によるとジグライムに可感なイミドーシロキサンポリマーを得たければ普通には使用しない、したがつてかなり高値な差されるであれば、シロキサン単位を含まればある。 別の一面でパージャー(Berger)が当れまするポリイミドのがで、シロキサン単位を含するポリイミドが従来のポリイミドのガラス転移温度(Tg)の350℃に比べてずつと低い、たとえば/40℃程度のTg を有しているということである。 したがのでまたらは従来技術のポリイミドより容易に格別流動するであろう。

発明の概要

本発明の1つの目的は、通常使用しない高値な材料から製造するのではない、ジグライムに可溶なシロキサン・イミドコポリマーを提供することである。

本発明の別の目的は、従来技術のシロキサン

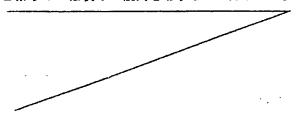
特開昭61-118424 (6)

- イミドコポリマーや有徴イミドポリマーより広い有用な加工処理範囲を有する組成物を得るべく 2つのガラス転移復度をもつシロキサン・イミドコポリマーを提供することである。

その他の目的と利点は以下の本発明の説明と 添付の特許請求の範囲の記載から当業者には明ら かであろう。

本発明はその最も広い面において、ガラス転移温度が低いポリマーブロックを少なくとも!つとガラス転移温度が高いポリマーブロックを少なくとも!つ有するジグライム可科性シロキサン・イミドコポリマーからなる。

このジグライム可容性のシロキサン・イミド コポリマーは次の一般式を有するのが好ましい。



HO OH O O | || || || || -NC-, -CN-, -C-O-, または-O-C

であり、 R^3 は最換または非量換のヒドロカルビ レンである。 また上配式中、各 R^1 はそれぞれ 独立に選択された世換または非量換のヒドロカル ビル基であり、 R^2 は

(ただし、 R は 農素原子を / ~ 9 個有するアル

$$\begin{pmatrix}
0 & 0 \\
|| & || \\
C & C \\
N & Ar & N-R & \begin{cases}
R^i \\
SiO \\
R^i \\
R^i
\end{pmatrix} & \begin{cases}
R^i \\
Si \\
R^i
\end{cases} & R
\end{pmatrix}$$

ここで、各 Ar はそれぞれ独立して選択された芳香族基であり、 B は置換もしくは非置換のヒドロカルビレン基または必式の基である。

$$-Q-Z-R^{5}-$$
.

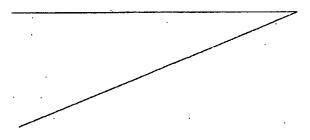
ただし、Qは魔換または非量換の芳香族基であり、 Zは

キル基であり、 R⁵ は炭素原子を/〜 4 優有する アルキレン基である)から成る群から選択された 基であり、 Y は酸素またはイオウであり、 a, b, c および c は全て/ に等しいかまたはそれ以上の 整数である。

🤄 発明の説明

本発明によつて、低いガラス転移温度(Tgi)のポリマーブロックを少なくとも1つと高いガラス転移温度(Tg2)のポリマーブロックを少なくとも1つとを有するジグライム可容性シロキサン・イミドコポリマーが得られる。

通常本発明のジグライム可俗性シロキサン -イミドコポリマーは次の一般式(I)をもつている。



特開昭61-118424 (7)

$$\begin{pmatrix}
O & O \\
ii & ii \\
C & C \\
N & Ar & N-R & \begin{cases}
R^i & R^i \\
SiO & Si - R \\
R^i & R
\end{cases}$$

ここで、各 Ar はそれぞれ独立して芳香族基であり、Rは世換もしくは非世換のヒドロカルビレン 基または次式の基である。

$$-Q-Z-R^5-$$

ただし、Qは世換または非置換の芳香族基であり、 2は

ただし、 R⁴ は炭素原子をノ〜9個有するアルキル基であり、 R⁵ は炭素原子をノ〜4個有するアルキレン基である。 さらに上配一般式(II)中、Yは酸素またはイオウであり、 a, b, c および n は全てノに等しいかまたはそれより大きい整数である。

本発明のコポリマーの低いガラス転移値度(約-//0~約0℃が好ましい)を有するブロックは次式(N)のシロキサン・イミドポリマー単位から待られる。

$$(N) \left\{ \begin{array}{c|c} O & O & \\ & & & \\ C & C & \\ & N & Ar & N-R & \begin{pmatrix} R^1 & & & \\ & SiO & & \\ & & & \\ & & R^1 & \\ & & & & \\ & & & R^1 \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\$$

さらに、ジオルガノシロキシ単位が存在するため ある程度の柔軟性すなわち可撓性、たとえば低温 での弾性も最終生成物に付与され得る。

このようなポリマーの製造は業界で周知であ.

であり、 R^3 は世換または非世換のヒドロカルビレンである。 また上記一般式(I)中、各 R^3 はそれぞれ独立に選択された世換または非世換のヒドロカルビル基であり、 R^2 は次のものから成る群から選択された基である。

り、たとえば米国特許第3.3.2.5.4.5.0号 および第 4.3.9.5.5.2.2.7.4 (これらの両者を授用して本明細書 の開示内容に含める)の数示するところに従つて 製造できる。 一般に、二無水物をジアミンと、 特に本発明ではジアミノで末端停止したポリジオ ルガノシロキサンと、反応させてポリアミド酸を 形成し、その後このポリアミド酸を加熱して緩化 することによつてポリイミドを製造する。

上記式 (N) 中の Ar は四価のペンゼンもしくはナフタレン核または次式の四価の基であることができる。

ここで、mはOまたは/であり、Eは次のものである。

ただしょはノーよの整数である。

さらに好ましい意様では、ジグライムに対する最終生成物の再解性を高めるようなジェーテル結合が式(IV)の Ar に包含される。 すなわち、 このさらに好ましい態様では式(IV)の Ar は次式の四価の残蓄である。

ことでGはフェニレンまたは次式の基である。

ただしEとmは既に定義したとおりである。

特に好ましい式(N)の Ar は次式を有するものである。

ヘテロ原子はN,OおよびSから選択される)で あり、スは

R¹ 基はそれぞれ独立に選択された一価で置換または非世換の、ポリシロキサンのケイ来原子に結合している典型的な基のいずれでもよい。 さらに好ましい R¹ 基にはメチル、エチル、プロビルまたはブチル基のような低級アルキル基、フェニル基、ビニル基、3.3.3-トリフルオロプロビル苦等がある。 当集者は最終生成物の所望の

道切な Ar 基と対応する二無水物反応体のさらに完全なリストは米国特許第4395.527号に見い出すことができる。

Rは世換または非世換のヒドロカルビレン基のいずれでもよく、たとえば、メチレン、エチレン、プロピレン、イソプロピレン、イソブチレンのように炎素原子を約 20 個まで有する直鎖もしくは分枝のアルキレン薬、骨格額が / 個以上のフェニレン基で中断されており炭素原子を約 20 個まで有するアルキレン基、または次式の基である。

$$-Q-Z-R^{5}-.$$

ここで、Qはフェニレンもしくはナフタレンのような量換もしくは非便換の芳香族ヒドロカルビレン基のいずれかまたは複素環式芳香族基(ただし、

特性に応じて適当な R³ 基とその他の基を、余分な実験をすることなく適当な割合で選択することができる。

上記の式(I)と(N)で、aは/に等しいかまたはそれより大きい任意の整数であることができ、/O.より大きいと好ましい。 また、nは/より大きい任意の整数であることができ、ケー約/OOが好ましい。

本発明では式(IV)で表わされる前記のポリマー単位に加えて、次式(V)の有機ポリイミド単位のプロックも少なくとも / つ存在する必要がある。

$$(V) \qquad \begin{pmatrix} O \\ II \\ C \\ N \end{pmatrix} \qquad \qquad Y - Ar - Y - O \begin{pmatrix} O \\ II \\ C \\ N - R^2 \end{pmatrix} \qquad \qquad b$$

これによつて、本発明のコポリマーの高いガラス 転移温度(約 /00~ 300 ℃が典型であり、/50 ~ 300℃が好ましい)を有するブロックが得られ ٥.

このような単位によつて最終生成物が熱可酸性を有するようになることは音楽者には理解されよう。 したがつて、本発明の新規な組成物は「熱可型性エラストマー」と最も良く扱わすことができる。

式(V)の Arは二個の芳香族基のいずれであることもでき、式(IV)の Ar 基よりは多少狭いのが好ましい。 すなわち、式(V)の

は、その芳香族基がYを介してフェニル基化二個 組合する必要があるという点で式(N)の Ar の重 排と考えるととができる。 Yは酸素またはイオ ウ瓜子であり、酸素原子が好ましい。 式(V)の 適当な Ar 基は当葉者が容易に決定できる。

本発明に従つてジグライム可称性シロキサン - イミドコポリマーを得るのに重大なことは、R²

いのが好ましい。

本発明の特に好ましい機様では式(IV)の構造単位の有機ポリイミド部分は式(V)の構造単位と同じである。 こうすると当業者は、式(IV)と(V)の中間体ポリマーを最初に形成する必要なく一段階で本発明の組成物を共重合することができる。 たとえば、式(IV)の中間体ポリマーは次式(A)の二無水物と次式(B)のアミノで末端停止したシロキサンを反応させて製造し、

が次のものから成る掛から選択された基でなければならないということである。

ここで、 R⁴ は炭素原子をノ〜9個有するアルキル券であり、炭素原子ノ〜3個が好ましく、メチルが最も好ましい。 また R⁵ は炭素原子をノ〜 ※個有するアルキレン基であり、炭素原子ノまたは2個が好ましく、メチレンが最も好ましい。

式 (V) で b は / に等しいかまたはこれより大きい任意の整数であることができ、 /O より大き

式(V)の中間体ポリマーは

と、たとえば次式

のジアミンとを反応させて製造する。 反応体(A)の Ar が次式を有する場合、



これは反応体(C)と同じである。 反応体(C)と(D)の反応は反応体(A)と(B)の反応に比べて極めて遠いことが判明した。 したがつて、反応体(D)が全部使い尽されるまでは有機ポリアミド酸プロックのみが形成され、 次いで残つている二無水物(すなわちAとC)とアミノシロキサンから酸アミド・シロキサンブロックが形成される。

しかし、反応対(A)と(C)が同一でない場合、 プロックコポリマーを得るためにはまず集界で公 知の方法によつて式(4)と(5)の中間体ポリマーを形 成する必要がある。 これらの中間体ポリマーが 形成されたらこれらを互いに重合させて本発明の 組成物を形成する。 本発明のコポリマーの他の 製造方法は当業者には自明であろう。

上述した組成物は半導体、電子デバイス等の

援用によつて本明細書中に包含する)には、次式 の感光性ポリアミド酸組成物からホトレジストが 製造できることが開示されている。

ここで、Rは四価の有機基または四価のオルガノシロキサン含有基であり、 R¹ は二価の有機基または二価のオルガノシロキサン含有基であり、 A は R 光性のアクリレート、 シンナメートまたは 2。3 - ジフェニルシクロプロペノールエステル含有基である。

たとえば、クレイ(Kray)が繋外に数示しているように、ポリアミド酸をシリコンウェーハのような基板に塗布し、次にこの基板にマスクを付け、マスクされていない部分に架衡を起こさせるように光源にさらし、その後架構したポリアミド

保護コーティングの分野で特に有用であろう。 本発明のコポリマーは単に従来技術の有機ポリイミドとシロキサン・イミドの中間のガラス転移経 度を示し、したがつてそのような従来技術の相互を 物の中間の有用な加工範囲を示すだけであると予 切されるであろうが、全く驚ってとに、起 明をなすこのような従来技術のポリイミドの組み 合せでは2種の異なるガラス転移温度を有すると 考えられる組成物が得られる。 こうして、本発 別によつて、従来技術の数示から予期される あうよりもずつと広い温度範囲で有用な新規なコポリマーが得られるのである。

本発明の別の一面において、かつ本明和書中に開示した組成物のジグライム部無性の結果として、ホトレジストの製造に有用な組成物を調製することが可能である。

/98%年/月2%日に出版されたW.D.クレイ(Kray)の同時係属中の米国出版香号第373 883号およびG.デイビス(Davis)の米国出版(これら双方とも本発明の歴受人に駆使されており、

は形けないが発着していないポリアミド取は好ける器様にホトレジストをさらすことによつて露光した基板を現像し、最後に現像したホトレジストをポリアミド酸がポリイミドに転換されるのに完分な温度に加熱する。 上述した理由により、ホトレジストの製造に本発明のジケライム可唇性組成物を使用することが望ましいであろう。 これは、式(I)のR基の/個以上にたとえば式

~ C - OH の基を結合することによつて容易に建成することができる。 このカルボン酸差は、本発明の組成物をイミド化した後、次式の感光性化合物と反応させることができる。

ここで、 R は炭素原子を/~8 傾有する二価の基であり、B は感光性のアクリレート、シンナメートまたは 2、3-ジフェニルシクロプロペノールエステルを含有する基である。 こうして、感光

性ポリアミド酸組成物ではなく感光性ポリイミド組成物が得られ、これは常用の方法によつてシリコンウェーハのような基板に塗布することができ、この塗被基体を所望のパターンが得られるようにマスクで被疑した後週当な光波にこの基体を第光し、その後この移光した基体を、適当な存在によって現像する。 クレイ(Kray)の場合とによって現像する。 クレイ(Kray)の場合と同様に架橋していない組成物は再数に可耐であり、一方架橋した組成物は不耐である。 感光性の表が結合している本発明の組成物を使用することの利点は、ホトレジストを高温にさらしてイミド化を起こさせる必要がないことである。

当業者が本発明をさらによく理解できるよう に以下に限定するためではなく例示のために実施 例を挙げる。 他に特配しない限り部は金て重量 による。

実施例

以下の実施例で本発明の実施を例示するために使用したモノマーは次のとおりである。 8DA 3.3'-スルホニルジアニリン

後室温でSDAを1.248(2005年ル)加えた。 激しく検控しながら室温で24時間反応を続けた。 可溶性ポリアミド酸溶液を得た。

実施例 /b

実施例 / a に配載の手順を繰り返した。 ただし、反応体としては無水 NMP 20 14中の BPADA 260 8 (2005 モル)と MDA 299 8 (2005 モル)を使用した。 宜価で 24 時間反応させて可容性のポリアミド酸を得た。 実施例 / d

実施例 / a に配数の手順を繰り返した。 ただし、反応体としては無水 NMP 30 配中の BPADA 6248(20/2モル)と ODA 2498 (20/2モル)を使用した。 宝温で 24 時間反

BTDA 3. 3. 4. 4. 4. - ベンゾフェノンテトラカル ボン酸二紙水物

TDA 2.4-トルエンジアニリン

MDA メチレンジアニリン

GAPDS
$$H_2N - (CH_2)_5 - \begin{pmatrix} CH_5 \\ 1 \\ SiO \\ 1 \\ CH_5 \end{pmatrix}_1 - (CH_2)_5 - NH_2$$

ODA オキシジアニリン

BPADA ピスフェノール・A - 二無水物

GAPPS-9
$$H_2N$$
-(- CH_2) $=$

$$\begin{pmatrix}
CH_5 \\
SiO \\
CH_4
\end{pmatrix}$$
 $=$

$$CH_5$$
 $=$

$$Si$$
 $=$

$$CH_5$$
 $=$
 $=$

$$CH_5$$
 $=$

$$CH_5$$

PMDA ピロメリト酸二無水物 実施例 /a

/00mの丸底フラスコに BPADA を 260 8 (2005モル) および無水N - メチルピロリドン (NMP) を 25 が入れた。 BPADA を将探した

応させて可格性のポリアミド酸を得た。

突然例 24

丸座フラスコに BTDA を & 448 (0.02 モル) と無水 NMP を 27 8 入れた。 BTDAが 密解した 後帯液に TDA を 3668 (0.03 モル) 宝温で加えた。 別のフラスコで、 BTDA & 448 (0.02 モル) を無水 NMP 348 中で GAPPS - 9 8408 (0.01 モル) と反応させた。 これらの 2種の 密液を / 6 時間 反応させ、この時点で 2つを一緒にし、さらに 48 時間 宝温で 反応させて 均質な ポリアミド 歌密液を 待た。

実施例 2b

丸底フラスコに PMDA を 5.43 8 (0.02 モル)、 ODA を 4.00 8 (0.02 モル)、 および無水 NMP を 5.5 配入れた。 反応を室盤で 2 時間行ない、 この時点で番液に GAPPS - 9 を 8.40 8 (0.07 モ ル) 加えた。 反応をさらに 48 時間続けて可容 性のポリアミド酸器被を得た。

実施例 3 a

/00 型の丸底フラスコに BPADA を 2.28 8

(Q.O/ 4 モル)、 GAPDS を 3488 (Q.O/ 4 モル)、および無水 NMP を 30 単入れた。 反応を 室温で 24 時間実施してポリアミド酸溶液を得た。 実施例 3 b

/00 配の丸底フラスコに BPADA を 2.808 (QO/5 モル)、TDA を 1.228 (QO/モル)、 および無水 NMP を 40 配入れた。 電温で3 分間 欲しく提拌した後、GAPPS - 9 を 4.208 (QOO5 モル)加えた。 反応を 24 時間続けて可存性の ポリアミド酸溶液を得た。

実施例 30

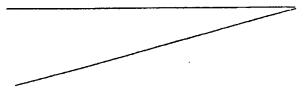
さらに火み時間反応させた。

実施例 5

上記の溶液を Q 070×4×4 インチのテフロン (Teflon®) 製金型内に注ぎ、強調空気流オープン中約 / 25℃で 20 時間、その後別の強調空気流オープン中約 250℃で45 分間加熱することによってイミド化を実施した。 20 インチ/分のクロスヘッド速度を用いる標準法によって各サンプルの引張強さをテストした。 結果を表 [に示す。

実施例 6

次に、引送強さの測定に使用した注形フィルムの小片をよ~ 20 倍の重量のジグライム中に入れ、90℃で約 / 5分加熱した。 このジグライム 密解性テストの結果も表した示す。



実施例 3d

/00 配の丸底フラスコに BPADAを / 4/2 $g(QO3/\mp LL)$ 、メチルエチルケトン (MEK) BO3中の ODAを 4 O3 (QO3 ELL)、および無水 NMPを 3 ELL 3 ELL 4 ELL 5 ELL 6 ELL 7 ELL 8 ELL 8 ELL 8 ELL 9 ELL

突施例 《 2

/00 Mの丸底フラスコに BPADA を / Q 4 8 (Q 0 2 元ル)、GAPPS - 9を / 7.648 (Q 0 2 / 元ル)、および無水 NMP を 60 M 入れた。 別の / 00 M の丸匠フラスコに BTDA を 4 / 8 8 9 (Q 0 / 3 元ル)、TDA を / 4 6 6 8 (Q 0 / 2 元ル)、および無水 NMP を 25 M 入れた。 これらの唇液を含まる 24 時間反応させ、この時点でこれらを互いに混合し、可器性のポリアミド酸を得るように

表「I

突施例	ブロック構造	ジグライム 溶解性	引張強さ(psi)
/2	(BPADA - SDA)	なし	能すぎてテスト できない
/ b	(BPADA - TDA)	なし	3500
/ c	(BPADA-MOA)	なし	施すぎてテスト できない
/ d	(BPADA - ODA)	・なし	施すぎてテスト できない
2 a	((BTDA - TOA)2 (BTDA - GAPPS -9))	なし	4700
2 b	((PMDA - TOA)2 (PMDA - GAPPS -9))	なし	脆すぎてテスト できない
<i>3</i> a	BPADA - GAPDS	あり	5350
<i>3</i> b	((BPADA-TDA)2 (BPADA-GAPPS -9))	あり	4600
<i>3</i> c	((BPADA-MDA) (BPADA-GAPPS -9)20)	・あり	3500
<i>3</i> d	((BPADA-ODA) (BPADA-GAPPS -9) zo	あり	6100

これらの結果が示しているのは、本明細書中 に開示した表示を実施したときにだけ、低ガラス 転移温度のポリマープロックを少なくとも / つと 高ガラス転移温度のポリマープロックを少なくと も / つを有するジグライムに可唇なポリイミドが 得られるということである。

> 特許出版人ゼネテル・エレタトリック・カンパーイ 代理人 (7830) 生 沼 徳 二

THIS PAGE BLANK (USPTO)